

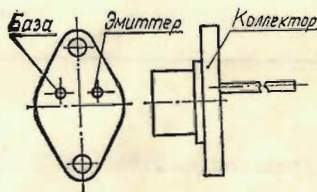


Транзисторы 2Т812А, 2Т812Б

ЭТИКЕТКА

Кремниевые меза-планарные p-p-n транзисторы в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами предназначены для работы в высоковольтных импульсных и ключевых схемах аппаратуры специального назначения.

Масса транзистора не более 20 г



Корпус типа КТ-9 ГОСТ 18472-88

Основные электрические параметры при $T_{\text{корп.}} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначен.	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора, мА Икб=700 В для 2Т812А Икб=500 В для 2Т812Б	Икбо		5 5
Обратный ток эмиттера, мА Иэб = 6 В	Иэбо		50
Статический коэффициент передачи тока Икэ=3 В, Ик=8 А	h21э	5	—
Напряжение насыщения база-эмиттер, В Ик=8 А, Iб=1,6 А	Ибэнас	—	2,5
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В Ик=8 А, Iб=1,6 А,	Икэнас	—	2,5
Граничное напряжение, В Ик=100 мА, L=40 мГн,	Икэогр	350	—
Время спада, мкс Ик нас=5А, Икк=250 В, Iб нас=Iб зап=2,5 А, tпас=tзап=40 мкс, Ибэ огр= -4 В	tсп		1,3

Содержание драгметаллов в 1000 транзисторов:

Золота — 17,0125 г

Содержание цветных металлов и их сплавов в 1000 шт.

Наименование цветного металла или сплава	Марка	Масса, г
Медь	МОБ	2900

Сведения о приемке

Транзисторы 2Т812А, 2Т812Б соответствуют техническим условиям АА0.339.193ТУ

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Штамп ОТК



Штамп
представителя заказчика



Место для штампа «Перепроверка произведена»* _____ дата

Приняты по извещению № _____ от _____ дата

Штамп ОТК

Штамп
представителя заказчика